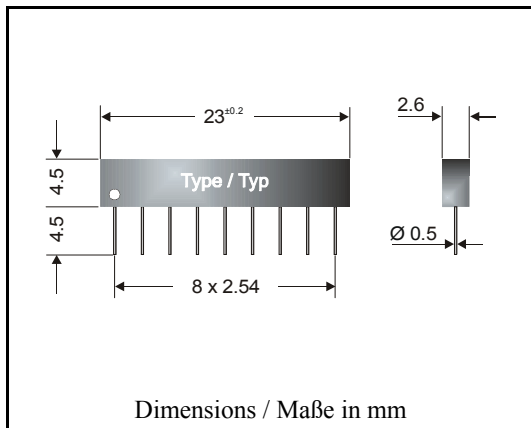
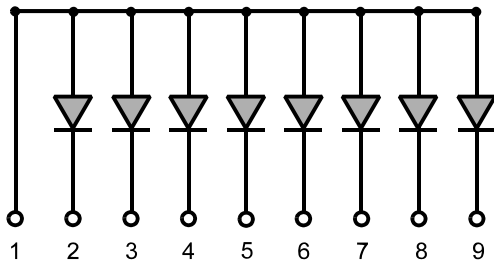


Fast Switching Rectifier Arrays

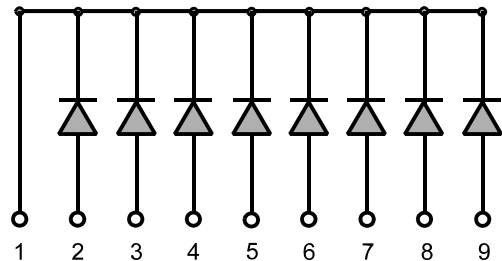
Schnelle Gleichrichter Sätze



Nominal power dissipation	1.2 W
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	100...400 V
Periodische Spitzensperrspannung	
9 Pin-Plastic case	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K": com. cathodes / gem. Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV}	600 mA ¹⁾
I_{FAV}	150 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV}	600 mA ¹⁾
I_{FAV}	150 mA ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM}	30 A
-----------	------

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	$1.2\text{ W}^1)$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.3\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$ $< 90\text{ }\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	$< 350\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 85\text{ K/W}^1)$

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten